

微視的光学表面フォノンの実験的検証

近年,固体の表面科学は半導体技術や触媒技術を中 心に材料科学の大きな一つの研究分野を形成しつつあ る。固体の表面付近の化学組成分布や原子構造の研究 は急速な勢いで進展しているが,格子力学を含む幾つ かの領域はまだ未開拓の分野であり,研究の緒につい たというのが現状であろう。ここでは、本研究所にお いて最近実験的に初めて観測され、今後大きな発展が 期待される微視的光学表面フォノンについて紹介する。

固体表面上の特異な多くの現象は表面最外層の原子 の化学結合の一部が切れていることに原因する。例え ば、表面の原子間隔や電子状態は固体内部とは一般に 第12研究グループ 主任研究官 大島忠平

異なる。また原子振動についても、化学結合の手が少 ないため、内部の原子と比較すると表面の原子は振動 しやすくなっている。即ち、表面原子の固有振動数は 内部の原子の振動数よりも低くなる傾向がある。

今、化合物を考える。化合物の格子振動(フォノン) には2種類の振動モードが存在する。即ち,結晶の単 位胞内の異種原子の変位が逆位相である光学フォノン・ モードと同位相の音響学フォノン・モードである。こ の2つのフォノン・バンド間にはエネルギー・ギャッ プが存在する。今、高い振動数をもつ光学フォノンの振 動数が固体表面で低下し,たまたまエネルギー・ギャ



図 | 測定に使用した高性能電子エネルギー損失分光装置

ップ中に落ち込むと、固体内部には同じ振動数のモー ドが存在していないため、この振動モードは固体内部 へ伝播することができず、表面1~2原子層に局在す ることになる。これが、16年前にLucas⁽¹⁾ と Wallis 等⁽²⁾によって独立に理論的な議論が始まった微視的 光学表面フォノン(Microscopic Optical Surface Phonon) である。それ以来今日まで多くの理論的な 議論がなされ、実験的な検証が待たれていた。最近、我 々の研究グループにおいて実験装置の改良によって、 幾つかの炭化物表面上で、この微視的光学表面フォノ ンの1つのモードを実験的に観察することに成功した⁽³⁾

今回使用した高性能電子エネルギー損失分光装置の 写真を図1に示す。電子銃で放射した電子ビームを2 段の円筒静電型モノクロメーターにより単色化し、エネ ルギーを揃える。この単色電子ビームを試料表面に絞っ て照射し、反射した電子のエネルギーを2段のアナラ イザーで分析する。この装置の開発の際、特に留意し た点はスペクトル中のバックグランドの軽減とエネル ギー分解能の向上である。4個の円筒静電型分析器の 偏向角をコンピューター・シュミレーションによって 最適化した。このことにより,従来の装置に比較して, バックグランドが約1桁低く,またエネルギー分解能 が3meV以下の世界最高の性能が実現している⁽⁴⁾

図2は清浄なTaC(100)面の典型的なEELSスペク トルである。スペクトルAは超高真空中で1900°Kで フラッシュ加熱した直後のスペクトルであり, Bは 130°Kに冷却した表面から測定したスペクトルである。 これらのスペクトルには57.4meVにロス・ピーク(エ ネルギーを失なった電子),また-57.4meVにゲイン・ ピーク(エネルギーを得た電子)が観察される。試 料の温度が下がると、このゲイン・ピークとロス・ピ ークの強度比はボルツマン項Exp(-hω/kT)に従って 減少する。ここでhω=57.4meVでkおよびTはボル ツマン定数と試料の絶対温度である。これは1個のフ ォノンの励起・吸収過程から期待される温度変化であ る。このロス・ピークは次のような性質をもっている。 (1)このロス・ピークは清浄なTaC(100)面固有のもの

であり、汚れた表面では観察されない。

(2)ピーク強度の温度変化は1個のフォノンの励起過 程として説明できる。



図 2 TaC(100) 清浄面の EELS スペクトル



図3 ロス・ピーク強度の入射角依存性

(3)観測した振動数は固体内のフォノン・バンドのエネルギー・ギャップ中に落ち込む。

(4)このロス・ピークは微視的な表面変化に敏感である。例えば表面上に酸素が吸着すると、このピークは消滅する。また(111)清浄表面では、このロス・ピークは観察されない。

性質(3),(4)は似たような表面の振動である表面フォ ノンポラリトンとは異なり,観測した振動が最外層近 傍のみに局在することを示している。(1)-(4)の性質か ら,観測した振動には,次の2つの原因が考えられる。

(1)表面の欠陥(例えばステップや原子空孔)に局在 した振動モード。

(2) 微視的光学表面フォノン

しかし,表面の欠陥を高感度に検出できる直衝突イ オン散乱分光の実験では欠陥が検出されない。このた め、残る有力な原因が微視的光学表面フォノンとなる。

更に振動モードの詳細を調べるために、EELSス ペクトルの角度変化を測定した。図3に入射角を変え て測定したロス・ピークの強度変化を示した。横軸は 鏡面反射方向からのずれの角度である。図3に示すよう に鏡面反射方向に鋭いピークが存在するが、このピーク は双極子散乱の特徴であり、この結果は観測した振動 モードが長波長領域では表面に垂直方向の双極子モー メントを生ずる変位成分をもつことを示している。理 論計算とこの結果の対応から、この観測した振動モー ドは長波長領域では表面に垂直方向の原子変位をもつ S_2 モードと決定される。⁽⁵⁾ 図4にこのモードの Γ 点(長 波長領域)での原子変位を示すが、最外層の炭素原子 が第2層のTa原子に対して表面垂直の方向に振動し ていることが分かる。

最近接原子相互作用のみを考えたモデルで、この振動モードの振動数を計算すると Γ 点で $\sqrt{Ko/\mu}$ となる⁽³⁾



図 4 微視的光学表面フォノン(S₂モード) の
Γ 点 での原子変位。

ここでKoは炭素とTa原子間の力の定数で、 μ は換算 質量である。Koを固体内部の値を用いた時の計算値と 測定値を図5に示す。測定値はフォノン・バンドのギ ャップ内にあり、その分散は小さい。図5での計算値 と測定値との差はモデルが単純すぎることと、最外層 原子のKoとして固体内部の値を使用したことに原因 する。今、この差を総て力の定数の変化で説明しよう とすると、表面原子の力の定数を15%大きくする必要 がある。同様なS2モードはTiC(100)清浄面でも観測 されている。測定した振動数は力の定数の増加がTiC 表面で更に大きいことを示している。力の定数の正確 な値は更に進んだ理論的研究が必要であるにしても、 この結果はTiC表面ではTaC(100)表面に比較して強 い原子緩和や電子緩和が起っていることを示唆している。

現段階での本研究の意義は炭化物表面上の微視的光 学表面フォノンが実験的に観測できることを示したこ とにある。今後のデーターの集積と解析によって表面 融解や表面原子構造の安定性,また触媒や腐触等の表 面反応の機構への深い理解がなされ,この表面フォノ ンに関する研究が新材料開発の新しい有力な手法とな ることが期待されている。



図 5 S₂モードの分散関係

引用文献

- 1) A. A. Lucas, J. Chem. Phys. <u>48</u>, 3156(1968).
- R. F. Wallis, D. L. Mills and A. A. Maradudin, in <u>"Localized Excitation in Solids"</u> edited by R. F. Wallis (Plenum, New York, 1968) P. 403.
- C. Oshima, R. Souda, M. Aono, S. Otani, Y. Ishizawa, To be published in Phys. Rev. B. 30(1984)5361.

塩化ナトリウム形成体の製造方法

発明者 福長 脩 大沢 俊一 公 告 昭和58年第012208号 登 録 第1184060号

概要

本発明は,超高圧高温状態での材料合成に有効な圧 力媒体としての塩化ナトリウム成形体の製造方法に関 するものである。

従来知られていた圧力媒体には、天然産の葉ロー石、 カトリナイト,滑石,又はMgO,Al₂O₃,SiO₂,ソー ダガラス,低ソーダガラスなどの合成品があるが、こ れら天然産の材料は超高圧条件ではガス成分が反応容 器内に閉じ込められる傾向を持つため、ダイヤモンド や立方晶窒化ほう素の合成に好ましくない影響を与え、 又合成品は、高温高圧力では固体であるため、内部に 大きな圧力勾配が生ずるなど使用上困難な点がある。

本発明に係る塩化ナトリウム成形体の製造方法は、 原料としての塩化ナトリウム粉末,結晶塊体等,ガス 成分を含まない高純度品を重量%として、50%以下, 好ましくは0.5~15重量%の範囲で加え,かつ,成核剤 の粉末粒度は10µm以下,好ましくは0.01~2µm である成核剤を分散させた状態で核原料塩化ナトリウ ムを耐火性ルツボ中で溶融し,型中で鋳込み,押圧し た所望の塩化ナトリウム成形体を製造する方法であり, これにより,粗大な結晶粒の成長を防止し,全体が均 質な微結晶塩化ナトリウムと成核剤の混合体である成 形体を提供する。

1. 上ピストン 8. 電極板
2. 下ピストン 9. ヒーター
3. 耐圧シリンダー 10. 合成用試料
4. ガスケット 11. 塩化ナリウム成形体(管状)
5. 通電シリンダー 12. 塩化ナトリウム成形円板
6. 絶縁体 13. 塩化ナトリウム成形円筒
7. ワッシャー
8 6 1
4
3-7
13
7
10
4
8' 12 9 2 6'

炭 化 珪 素 焼 結 体 の 製 造 法

発明者 猪股 吉三 田中 英彦 公 告 昭和58年第009785号 登 録 第1184064号

概要

本発明は,炭化珪素焼結体の製造法の改良に関するも のである。 従来、炭化珪素焼結体の製造法として

- (1) 10ミクロン以下の炭化珪素粉末に、0.5~5重量
 %のアルミニウム又はアルミニウム化合物を加え、
 不活性雰囲気中で1950℃以上で加圧焼結する方法
- (2) β型炭化珪素粉末に、0.3~3.0重量%の硼素に 相当する硼素添加物および0.1~1.0重量%の炭素に 相当する炭素添加物を加えて、1950~2300℃で不

- C. Oshima, R. Souda, M. Aono, Y. Ishizawa To be published in Rev. SCi. Instruments.
- G. Benedek, M. Miura, W. Kress and H. Bilz Phys. Rev. Lett. 52, 1907 (1984).

活性雰囲気中で焼結する方法が知られている。

本発明は炭化珪素粉末,好ましくは粒径5ミクロン 以下の粉末に,焼結体内において総量で0.15~0.60重 量%となる量の硼素系およびアルミニウム系の両焼結 促進剤と,原料および添加物が随伴する酸素を一酸化 炭素とし,硼素,アルミニウムおよび反応によって生 成する珪素を炭化物として固定するに必要な炭素なら びに炭化珪素の0.1~0.5重量%の炭素を供給する炭素 系添加物を混合し,必要に応じ粉砕乾燥した後,不活

外	部	発	表
• 1			

※ 口 頭

性雰囲気下で、1850~2200℃で焼結する方法である。

本発明によると、硼素系およびアルミニウム系の両 焼結促進剤を同時に使用することにより、少量の焼結 促進剤で焼結を可能にすると共に、均一分散を容易に し、かつ炭素系の添加物の適量の添加により焼結体内 の酸素分を除去し得、これにより、焼結助剤が焼結体 内で異相を形成することなく、すべてSiC 中に固溶さ れ、そのため高温でも高強度・耐酸化も優れる等の優 れた物性を有する炭化珪素焼結体の製造法を提供する。

題	B	発	表	ŧ :	者	学·	協	会 等	発表日
Complexes of Apatitic Layer $Ca_8(HPO_4)_2(PO_4)_4 \cdot 5H_2O$ with	ed Compound h Dicarboxylates	門間	英毅・	後藤	優	国際抱	接化学	之会議	7月26日
Intercalation of a Modified C Copper(II)-Montmorillonite	yclodextrin by	木島 松井	岡・ 佳久	小林争	 〔 智子	国際抱	接化学	全議	7月26日
ニューセラミックスの開発現況	兄と展望	白嵜	信一			資源開	発大学	校	8月3日
In-situ Observation of Phase tion in 9R Polytype of SiC a	e Trans Forma- at 2000℃	井上薯	善三郎・	瀬高	信雄	国際結	晶学会	à	8月10日
The Crystal Structure of Zng	₂ Ti ₁₈ S ₃₂	川田 佐伯	功・ 昌宣	小野田	みつ子	国際結	晶学通	進合会議	8月13日
Structure Analysis of Semico Inorganic Compound Surfac Collision Ion Scattering Spec	onductor and es by Impact ctroscopy	青野 大島 石沢	正和 · 忠平 · 芳夫	左右田 大谷	龍太郎 茂樹	表面構造	造国際	除会議	8月13日
Chemical Potential of Fine	Powder System	猪股	吉三			U.SJap	oan Se	eminar	8月13日
Diffusional Creep of Elastic S	Solids	猪股	吉三			U.SJar	oan Se	eminar	8月15日
Coexistance of Tridymite Po Cristobalite in Tridymite Cry	lymorphs and stals	貫井 O.W.	昭彦 Flörke			国際結	晶学会	注連合	8月17日
High-Temperature X-ray Dif using YAG laser beam	fractometer	井上著	喜三郎			国際結	晶学会	È.	8月17日
Phase Transformation in SiC	Polytypes	井上喜	客三郎			ハノー. ナー	バーナ	マ学セミ	8月21日
ニューセラミックスの合成と特	勿性	三友	護			国立小	山高早	承公開	8月24日
Valence Mixing in Ce Comp by Photoemission	ounds Observed	藤森	淳			Interna Confere Valence	ationa ence e Pluc	ll on ctuations	8月28日
Mg _{2-x} V _{1+x} O ₄ の粒表面形態		大島	弘歳			フラン	ス化学	全会	8月29日
Raman and Infrared Spectra threns $C_{34}H_{18}$ and Their Free Based on MINDO/3 Calculation	of Six Violan- quency Analyses on	上田 森	豊甫・ 和英・	石井 伊藤	紀彦 礼吉	日本化	学会		8月30日
A 400KV High Resolution-A Microscope Newly Construct	Analytical Electron ed	板東 松井部 田	義雄夫 克彦 嘉安	猪股 北見 本田	吉三 喜三 敏和	3rd As Confere Electro	ia Pa ence n Mic	cific on croscopy	8月30日
Spinodal Decomposition in (Examined by 1 MV HRTEM	Ti, Sn)O ₂	堀内 菊地	繁雄・ 武・	泉 富 内田	富士夫 健治	シンガ	ポーリ	レ科学院	9月1日
Experimental Observation or Surface Optical Phonon : Ta	f the Microscopic C(100)	大島 大谷 石沢	忠平 · 茂樹 · 芳夫	左右田 青野	龍太郎 正和	Interna Sympo Spectro on Soli	tional sium oscopi d Sui	on ic Studies rfaces	9月3日

—— ★ M E M O ★ ———

研究会

8月28日 第12回チタン酸塩研究会が「ゼオライト 触媒について」の議題で開催された。

9月14日 第2回高融点化合物研究会が「Si(111) 表面上の超薄金属膜の諸性質の高分解能電子エネルギ ー損失分光による研究」の議題で開催された。

9月27~28日 第7回炭化けい素研究会が「セラミ ックス粒界の構造」の議題で開催された。

9月29日 第13回チタン酸塩研究会が「無機イオン 交換体の核燃料再処理への応用」の議題で開催された。

外国人の来所

学位授与

下記の外国人の研究所の訪問があった。

- 8月6日 崔湘浩(中国)吉村大学物理化学研究所講 師
- 8月8日 洪根哲(韓国)他 筑波大学留学生
- 8月14日 王玉霞 中国科学技術大学
- 8月22日 Prof. C.R.L.Goodman 英国 Standard Telecommunication Laboratory
- 9月4日 剧哲民他 第2次中国人工晶体研究所訪日 視察団
- 9月6日 葛庭燧他 中国科学院固体物理研究所
- 9月12日 Hisao Yamada 米国ユタ大学助教授
- 9月14日 Dr. J. Kirschner 西ドイツユーリッヒ原 子核センター
- 9月21日 Prof. Dr. Rohrbach 西ドイツ国立材料試 験研究所
- 9月24日 Dr. A. G. Godovikov ソ連ノボシビルス ク地球科学研究所

9月28日 Kim Eui-Tae他 韓国財界クラブ記者

9月28日 ジーン・グレゴリー(米国)上智大学教授

海外出張

第3研究グループ主任研究官井上善三郎は、「第13 回国際結晶学会」に参加のため、西ドイツへ昭和59年 8月7日から昭和59年8月23日まで出張した。

第3研究グループ総合研究官猪股吉三は、「日米セ ミナー(構造用セラミックスの基礎)」に参加のため、 米国へ昭和59年8月12日から昭和59年8月17日まで出 張した。

第12研究グループ主任研究官青野正和は,「第1回 表面の構造に関する国際会議」に出席のため,米国へ 昭和59年8月11日から昭和59年8月19日まで出張した。

第4研究グループ主任研究官堀内繁雄及び第3研究 グループ主任研究官板東義雄は、「第13回太平洋地区 電子顕微鏡学会」に参加のため、シンガポールへ昭和 59年8月28日から昭和59年9月3日まで出張した。

第10研究グループ主任研究官田中順三は、「トリチ ウムの分離精製電解セル用に関する研究」のため、フ ランス リモージュ大学へ昭和59年8月31日から昭和 60年8月30日までの予定で出張した。

超高圧カステーション総合研究官福長脩は,「第22 回高圧研究グループ会議」に出席及び研究討論のため, フランス及び西ドイツへ昭和59年9月9日から昭和59 年9月23日まで出張した。

第12研究グループ総合研究官石沢芳夫は、「第2回 硬質材料科学国際会議」に出席のため、ギリシャ国ロ ードスへ昭和59年9月21日から昭和59年9月30日まで 出張した。

氏	名	論	文	名	授与年月日	授与大学	学位名
大谷	茂樹	フローティング び Va 族遷移金 関する研究	・ゾーン法に、 属炭化物の良	よる I Va 族及 質単結晶育成に	昭和59年9月25日	大阪大学	理学博士
発編集	行 日 後 ・ 発 行	昭和59年 科学技 NATIONA	10月1日 術庁 無相 L INSTITUTE	第 89 号 幾 材 質 研 究 5 FOR RESEARC	近 H IN INORGANIC MA	ATERIALS	
		〒305 茨切	成県新治郡桜村 18-51-3351	並木1丁目1番			